

半 导 体 学 报

第 11 卷 第 9 期 1990 年 9 月

目 录

- 垂直磁场中 $\text{GaAs-Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ 量子阱内类氢杂质束缚能计算
.....李树深 焦善庆 (647)
- 自发发射因子在外腔半导体激光器的模式选择和线宽压缩过程中的作用.....
.....郭长志 黄永箴 (654)
- GaAs/GaAlAs 量子限制 Stark 效应及自电光双稳现象的实验研究...吴荣汉
段海龙 曾一平 王启明 林世鸣 孔梅影 张权生 江德生 谢茂海 (659)
- 激光脉冲照射硅时若干物理量的计算.....朱振和 (664)
- 1.3 微米波长 InGaAsP 激光器产生的亚微微秒光脉冲的干涉自相关测量.....
.....贾 刚 孙 伟 衣茂斌 高鼎三 (674)
- Ge 衬底上的 II-VI 族化合物 MBE 生长研究.....
.....钟建国 谢钦熙 张恕明 乔怡敏 袁诗鑫 (680)
- 利用能量过滤成像技术对注氮 SOI 的研究.....段晓峰 都安彦 褚一鸣 (688)
- 多晶硅应变膜压力传感器.....王跃林 刘理天 郑心奋 李志坚 (694)
- N^+ 型重掺杂硅快速氧化新方法——氟化氢增强氧化之二.....
.....徐 强 徐元森 龙 伟 (698)
- 研究简报**
- 量子阱材料的电子显微镜及光致发光研究.....
.....范缙文 张永航 曾一平 陈良惠 徐 统 (706)
- 静压下 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 混晶的喇曼散射.....
.....李国华 韩和相 汪兆平 糜东林 郑健生 (709)
- SiGe/GaP 合金的高温退火特性.....高 敏 D. M. Rowe (713)
- 研究快报**
- $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As/GaAs}$ 和 $\text{GaAs/Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$ 量子阱的静压下光致发光的对照研
究.....李国华 郑宝真 韩和相 汪兆平 (718)
- GaAs/GaAlAs 半导体淬灭型双稳现象的实验研究.....
.....王守武 刘文旭 杨 朴 吴荣汉 (724)